

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой
материаловедения и индустрии наносистем



В.М. Иевлев
26.03.2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.06 Реальная структура материалов

- 1. Код и наименование направления подготовки/специальности:** 04.03.02 Химия, физика и механика материалов
- 2. Профиль подготовки/специализация:** материаловедение и индустрия наносистем
- 3. Квалификация выпускника:** бакалавр
- 4. Форма обучения:** очная
- 5. Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины:** кафедра материаловедения и индустрии наносистем
- 6. Составители программы:** Прижимов Андрей Сергеевич, кандидат физико-математических наук
- 7. Рекомендована:** научно-методическим советом химического факультета, протокол № 3 от 19.03.2020

отметки о продлении вносятся вручную)

8. Учебный год: 2022-2023

Семестр(ы): 6

9. Цели и задачи учебной дисциплины:

ознакомление студентов с дефектами в твердых телах, с их классификацией, характеристиками, взаимодействием дефектов друг с другом, влиянием дефектов на свойства твердых тел.

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:

Б1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями) и индикаторами их достижения:

Код	Название компетенции	Код(ы)	Индикатор(ы)	Планируемые результаты обучения
ПКВ-2	Способен использовать знания о методах синтеза и свойствах материалов различного назначения, в том числе наноматериалов, для решения профессиональных задач	ПКВ-2.1.	Способен выбирать методы синтеза материалов различного назначения (в том числе наноматериалов) в соответствии с поставленной задачей	знать: классификацию дефектов, их определения и основные свойства уметь: определять тип дефекта, вид дислокаций, их вектор Бюргерса, виды межфазных и межзеренных границ, структурные элементы и параметры специальных границ, атомную структуру поверхности владеть: методами анализа, проектирования научного исследования и прогнозирования свойств
		ПКВ-2.2.	Способен использовать знания о свойствах материалов для решения конкретных профессиональных задач	знать: классификацию дефектов, их определения и основные свойства уметь: рассчитывать межплоскостные расстояния, периоды сетки дислокаций, параметры сопряжения на межфазных границах; обрабатывать результаты исследований, владеть: современными методами исследования свойств материалов
ПКВ-3	Способен проводить обработку и анализ результатов исследования, полученных основными методами анализа веществ, элементного и фазового состава, структуры и свойств материалов (включая наноматериалы)	ПКВ-3.1	Обладает знаниями возможностей основных методов анализа веществ, элементного и фазового состава, структуры и свойств материалов (в том числе наноматериалов)	знать: основы кристаллографии, кристаллофизики и кристаллохимии. уметь: планировать оптимальное проведение исследования элементного, фазового состава и атомной структуры материалов владеть: навыками решения реальных задач исследования структуры материалов (в том числе наноматериалов);
		ПКВ-3.2	Способен обрабатывать и анализировать результаты типовых методов исследования состава, структуры и свойств материалов (в том числе наноматериалов)	знать: основные возможности методов исследования состава, структуры и свойств материалов уметь: применять методы обработки и представления результатов измерений владеть: навыками планирования, постановки задачи и обработки результатов эксперимента

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час — 4/144

Форма промежуточной аттестации – экзамен.

13. Трудоемкость по видам учебной работы

Вид учебной работы		Трудоемкость			
		Всего	По семестрам		
			№ семестра	№ семестра 6	...
Контактная работа					
в том числе:	лекции	36		36	
	практические	36		36	
	лабораторные				
	курсовая работа				
Самостоятельная работа		36		36	
Промежуточная аттестация		36		36	
Итого:		144		36	

13.1. Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины	Реализация раздела дисциплины с помощью онлайн-курса, ЭУМК
1. Лекции			
1.1	Введение: от идеального кристалла к реальному	Понятие дефекта, классификация дефектоа	-
1.2	Точечные и одномерные дефекты	Точечные дефекты, концентрация точечных дефектов; дислокации, вектор и контур Бюргерса, энергия дислокаций, движение дислокаций, взаимодействие дислокаций друг с другом и с точечными дефектами, дислокации в ГЦК, ОЦК и ГПУ решетках	ЭУМК https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=6196
1.3	Дефекты упаковки	Дефекты упаковки, частичные дислокации Шокли и Франки, барьер Ломера-Коттрелла, тетраэдр Томпсона	ЭУМК https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=6196
1.4	Границы зерен и межфазные границы	Классификация межфазных границ и границ зерен. Атомная структура границ. Решетка совпадающих узлов. 0-решетка. Специальные межфазные границы. Межфазные и зернограничные дислокации.	ЭУМК https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=6196
1.5	Поверхность	Типы поверхности. Атомная структура свободной поверхности. Кристаллография поверхности кристалла. Рельеф поверхности, шероховатость	ЭУМК https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=6196
2. Практические занятия			
2.1	Точечные и одномерные дефекты	Определение концентрация точечных дефектов. Построение вектора и контура Бюргерса, расчет энергии дислокаций, определение механизма движения дислокаций, определение вектора Бюргерса дислокаций в ГЦК, ОЦК и ГПУ решетках	ЭУМК https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=6196

2.2	Дефекты упаковки	Диссоциация полной дислокации на частичные, расчет энергии частичной дислокации.	ЭУМК https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=6196
2.3	Границы зерен и межфазные границы	Классификация межфазных границ и границ зерен. Атомная структура границ. Расчет параметров решетки совпадающих узлов. Использование 0-решетки для прогнозирования ориентационных соотношений. Определение структурных элементов специальных межфазных границ. Определение вектора Бюргерса межфазных и зернограничных дислокаций	ЭУМК https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=6196
2.4	Поверхность	Определение типа поверхности. Расчет и построение заданной структуры поверхности. Элементы кристаллографии поверхности кристалла. Параметры рельефа поверхности	ЭУМК https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=6196

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Виды занятий (часов)				Всего
		Лекции	Практические	Лабораторные	Самостоятельная работа	
1	Введение: от идеального кристалла к реальному	2	2		2	6
2	Точечные и одномерные дефекты	10	10		10	30
3	Дефекты упаковки	4	4		4	12
4	Границы зерен и межфазные границы	12	12		12	36
5	Поверхность	8	8		8	24
	Итого:	36	36		36	108

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного освоения дисциплины, необходимо

- изучение основных и дополнительных литературных источников;
- выполнение практического задания.

Использование ЭУМК <https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=6196>

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необходимых для освоения дисциплины

а) основная литература:

№ п/п	Источник
1	Иевлев В.М. Тонкие пленки неорганических материалов: Механизм роста и субструктура : учеб. пособие / В.М. Иевлев. – Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2008. – 496 с.
2	Готтштайн Г. Физико-химические основы материаловедения / Г. Готтштайн ; пер. с англ. К.Н. Золотовой, Д.О. Чаркина под ред. В.П. Зломанова. – М. : Бинум. Лаборатория знаний, 2009. – 400 с.

б) дополнительная литература:

№ п/п	Источник
3	Павлов П.В. Физика твердого тела / П.В. Павлов, А.Ф. Хохлов. – М. : "Высшая школа", 1985. – 383 с.
4	Фридель, Ж. Дислокации / Ж. Фридель ; Пер. с англ. А.Л. Ройтбурда. – М. : Мир, 1967. – 643 с.
5	Хирт Д. Теория дислокаций / Дж. Хирт, И. Лоте; под ред. Э.М. Надгорного, Ю.А. Осипьяна. — М. : Атомиздат, 1972. — 598 с.

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)*:

№ п/п	Источник
6	http://www.elibrary.ru – научная электронная библиотека.
7	http://www.lib.vsu.ru – Зональная научная библиотека ВГУ.

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

№ п/п	Источник

17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ), электронное обучение (ЭО), смешанное обучение):

Проведение текущей аттестации и самостоятельной работы по отдельным разделам дисциплины.

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Специальных технических средств не требуется

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется содержанием следующих разделов дисциплины:

№ п/п	Наименование раздела дисциплины (модуля)	Компетенция(и)	Индикатор(ы) достижения компетенции	Оценочные средства
1	Введение: от идеального кристалла к реальному	ПКВ-2 ПКВ-3	ПКВ-2.1 ПКВ-2.2 ПКВ-3.1 ПКВ-3.2	Устный опрос
2	Точечные и одномерные дефекты	ПКВ-2 ПКВ-3	ПКВ-2.1 ПКВ-2.2 ПКВ-3.1 ПКВ-3.2	Устный опрос
3	Дефекты упаковки	ПКВ-2 ПКВ-3	ПКВ-2.1 ПКВ-2.2 ПКВ-3.1 ПКВ-3.2	Устный опрос
4	Границы зерен и межфазные границы	ПКВ-2 ПКВ-3	ПКВ-2.1 ПКВ-2.2 ПКВ-3.1 ПКВ-3.2	Устный опрос
5	Поверхность	ПКВ-2 ПКВ-3	ПКВ-2.1 ПКВ-2.2 ПКВ-3.1 ПКВ-3.2	Устный опрос
Промежуточная аттестация форма контроля - экзамен				Комплект КИМ

20 Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие процедуры оценивания

20.2 Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных средств:

1. Понятие дефекта, классификация дефектов.
2. Дислокации в ГЦК, ОЦК и ГПУ решетках.
3. Точечные дефекты, концентрация точечных дефектов.
4. Дефекты упаковки.
5. Вектор и контур Бюргерса.
6. Специальные межфазные границы.
7. Типы поверхности.
8. Энергия дислокаций.
9. Взаимодействие дислокаций друг с другом и с точечными дефектами..
10. барьер Ломера-Коттрелла
11. Классификация межфазных границ и границ зерен.
12. Межфазные и зернограничные дислокации.
13. Частичные дислокации Шокли и Франка.
14. Тетраэдр Томпсона.
15. Атомная структура межфазных границ.
16. Решетка совпадающих узлов. 0-решетка.
17. Движение дислокаций.
18. Атомная структура свободной поверхности
19. Рельеф поверхности, шероховатость
20. Кристаллография поверхности кристалла

Практические задания

1. Определить концентрацию точечных дефектов при заданной температуре в кристалле меди.
2. Построить дислокацию в ГЦК-кристалле. Определить ее вектор Бюргерса.
3. Построить контур Бюргерса.
4. Определить тип дислокации, приведенной на рисунке.
5. Рассчитать энергию полной дислокации в ОЦК-кристалле.
6. Доказать выгодность диссоциации полной дислокации в ГЦК-кристалле на две частичные дислокации Шокли.
7. Определить параметры специальной границы.
8. Построить поверхность с заданной атомной структурой.

Описание технологии проведения.

После получения студентом билета КИМ и бланка листа ответа, самостоятельно выполняются задания КИМ в письменной форме. Время подготовки 40 минут.

Требования к выполнению заданий, шкалы и критерии оценивания.

Оценка “отлично” ставится если студент дает полный и правильный ответ, раскрывая теоретические и практические аспекты вопроса, анализируя литературные источники по данному вопросу, аргументирует собственную позицию по данному вопросу

Оценка “хорошо” ставится если студент допускает несущественные ошибки, испытывает трудности при определении собственной оценочной позиции

Оценка “удовлетворительно” ставится если студент допускает существенные ошибки, нарушена логика изложения материала, требуются наводящие вопросы преподавателя

Оценка “неудовлетворительно” ставится при незнании или непонимании большей или наиболее существенной части содержания учебного материала